13,03

О механизме возбуждения плазменных колебаний в твердых телах, исследованных методом полного внешнего отражения рентгеновских лучей

© В.М. Стожаров, И.И. Хинич

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: gut1111@yandex.ru

Поступила в Редакцию 18 ноября 2020 г. В окончательной редакции 18 ноября 2020 г. Принята к публикации 11 января 2021 г.

Рассмотрен механизм возбуждения плазменных колебаний в твердых телах методом полного внешнего отражения рентгеновских лучей. Показано, что главную роль в возбуждении плазмонов в твердых телах играют медленные электроны, входящие благодаря вторично-электронному усилению в тонких поверхностных слоях твердого тела в состав многоэлектронных актов эмиссии в виде электронных пачек. Для карбида кремния проведен качественный расчет числа медленных вторичных электронов, порожденных рентгеновскими фотоэлектронам.

Ключевые слова: плазмон, плазменные колебания, электрон, электронная пачка, квантовый выход.

DOI: 10.21883/FTT.2021.05.50821.264

Новая методика полного внешнего отражения (ПВО) рентгеновских лучей основана на измерении интенсивности отраженных рентгеновских лучей при скользящем падении параксиального пучка рентгеновских лучей около 0.5', сформированного параболическим зеркалом. Запись рентгенограммы ПВО в режиме $2\theta - \theta$ обеспечивает получение дифференциальной кривой ПВО с максимумом [1-2]. Угловое положение этого максимума характеризует показатель преломления рентгеновских лучей и связанную с ним энергию плазменных колебаний [3]. Актуальность этой методики состоит в ее новом применении к исследованию дисперсии плазмонов в твердых телах, несущей информацию о их внутренних микронапряжениях, приводящих к деформации кристаллической решетки и электронной поляризации твердого тела [4].

Настоящая работа посвящена исследованию механизма возбуждения плазменных колебаний в твердых телах на основе работ по внешнему фотоэлектрическому эффекту в мягкой области рентгеновского спектра.

Следствием корпускулярно-волнового дуализма микрочастиц является резонансное взаимодействие между ними, которое становится особенно вероятным при совпадении их частот [5]. Этим объясняется большая вероятность возбуждения поверхностных и объемных плазмонов в случае упругого отражения медленных электронов с энергиями от 3 до 25 eV от щелочноземельных и благородных металлов, исследованная в [6], а также резонансное возбуждение плазмонов лазерным излучением в видимой области электромагнитного спектра с энергией кванта порядка 5 eV [7,8].

Для выяснения вопроса о механизме возбуждения плазмонов рентгеновскими лучами рассмотрены работы [9,10] в которых содержатся результаты исследования внешнего рентгеновского фотоэффекта в мягкой области рентгеновского спектра. В этих работах показано, что благодаря вторично-электронному усилению в поверхностных слоях твердого тела в вакуум выходят многоэлектронные акты рентгеновской эмиссии в виде электронных пачек [9]. Каждая такая электронная пачка содержит один быстрый фотоэлектрон, возбужденный рентгеновским квантом из атома твердого тела, и несколько медленных вторичных электронов, которые эмитируются из тонкого поверхностного слоя твердого тела под действием этого быстрого фотоэлектрона. Вторично-эмиссионное происхождение электронных пачек подтверждено исследованиями энергетических спектров рентгеновской фотоэмиссии из твердых тел [10], в которых была обнаружена большая группа медленных электронов с энергиями менее 10 eV подобно спектрам истинно вторичных электронов (ИВЭ), возбужденных первичным электронным пучком средних энергий [11]. В табл. 1 и 2 приведены результаты измерения средних численностей электронных пачек v_c, и рентгеновских квантовых выходов \varkappa_r для металлов и диэлектриков.

Численность электронных пачек обусловлена медленными вторичными электронами, возбужденными быстрыми рентгеновскими фотоэлектронами из зоны выхода ИВЭ. Известно [11], что зона выхода ИВЭ из диэлектриков почти на порядок больше зоны выхода ИВЭ из металлов. Сравнение табл. 1 и 2 показывает аналогичное соотношение численности электронных пачек ν_c , эмитируемых из металлов и диэлектриков.

Таким образом, механизм возбуждения плазменных колебаний в твердых телах методом ПВО рентгеновского излучения $CuK_{\alpha 1}$ с энергией кванта 8048 eV опре-

Фотокатод	$\varkappa_r, \%$	$\nu_c, \%$
Al	0.42	15.5
Ti	0.80	15.3
Cr	1.10	15.0
Fe	1.10	11.4
Sn	1.45	11.7
Au	2.04	6.0
Pb	2.06	_
Bi	1.71	11.3

Таблица 1. Значения величин κ_r и ν_c для металлов, измеренные с использованием излучения Си K_{α}

Таблица 2. Значения величин x_r и v_c для диэлектриков, измеренные с использованием излучения Cu K_a

Фотокатод	$\varkappa_r, \%$	$\nu_c, \%$
NaCl	0.60	25
KCl	0.78	21
KBr	0.80	27
CsCl	2.00	60
CsJ	2.30	70

Таблица 3. Значения \varkappa_r и η

Элемент	$\varkappa_r, \%$	η	Ζ
Al	0.42	0.20	13
Ti	0.80	0.30	22
Au	2.04	0.45	79

деляется исключительно медленными электронами с наиболее вероятной энергией (2-5) eV, возбужденными быстрыми рентгеновскими фотоэлектронами из зоны выхода λ медленных ИВЭ.

В заключение проведем качественный расчет числа медленных вторичных электронов, порожденных фотоэлектронами, которые возбуждаются рентгеновским излучением Си $K_{\alpha 1}$, из эпитаксиальной пленки карбида кремния. Карбид кремния является широкозонным полупроводником и для политипа $3C(\beta)$ кубической кристаллической структуры характеризуется шириной запрещенной зоны $\Delta E \sim 2.5$ eV. Для такого расчета необходимо знать величину зоны выхода λ медленных вторичных электронов, возбуждаемых быстрыми рентгеновскими фотоэлектронами. Для карбида кремния таких данных в литературе нет, но есть данные по вторичной

электронной эмиссии широкозонного полупроводника селена [11] с шириной запрещенной зоны $\Delta E = 2.7 \, \text{eV}$ близкой к значению ширины запрещенной зоны карбида кремния. Определенная методом эквивалентной подложки зона выхода ИВЭ из селена составляет $\lambda = 35$ Å. Примем это значение зоны выхода медленных вторичных электронов, возбужденных рентгеновскими фотоэлектронами, за зону выхода медленных электронов для карбида кремния. В литературе также не содержится сведений о рентгеновском квантовом выходе \varkappa_r для карбида кремния. Известно, что неупругое рассеяние электронов зависит только от порядкового номера элемента Z [11]. В табл. 3 для трех элементов сопоставляются коэффициенты неупругого отражения электронов η с квантовым выходом рентгеновских фотоэлектронов \varkappa_r , взятые из табл. 1.

Видно, что имеет место корреляция между значениями κ_r и η . Поэтому с хорошим приближением можно использовать в дальнейших расчетах для карбида кремния по данным табл. 1 величину квантового выхода рентгеновских фотоэлектронов $\kappa_r = 0.42\%$ и среднюю численность электронной пачки $v_c = 15.5\%$ для алюминия, поскольку Z алюминия близок к Z карбида кремния.

Квантовый выход рентгеновских фотоэлектронов $\kappa_r = 0.42\%$ означает, что один квант рентгеновского излучения в среднем порождает 0.0042 электрона. Из наших измерений ПВО рентгеновских лучей на рентгеновском дифрактометре ДРОН-7 с острофокусной рентгеновской трубкой и параболическим зеркалом следует, что интенсивность отраженного от поверхности при скользящем падении под углом $lpha \sim 0.02^\circ$ рентгеновского излучения составляет $N_2 = 20\,000\,\text{quant/s}$ при интенсивности первичного излучения, падающего на образец, $N_1 = 66\,000\,\text{quant/s}$. Уменьшение первичной интенсивности на $\Delta N = 46\,000\,\text{quant/s}$ происходит в результате возбуждения фотоэлектронов, в первую очередь К-оболочки кремния с энергией $E_{\rm ph} = 8048 \, {\rm eV} - 1838 \, {\rm eV} = 6210 \, {\rm eV}$ и оже-электронов с энергией $E_{auger} = 1640 \text{ eV}$. При этом образуется 193 electron/s, а за время экспозиции t = 33 min = 1980 sслое карбида кремния $h = 120 \,\text{\AA}$ образуются в $n = 382\,530$ electrons. Однако не все эти фотоэлектроны создадут пачку медленных вторичных электронов, а только те из них, которые дважды пересекут зону выхода $\lambda = 35$ А медленных ИВЭ. Учитывая этот факт, а также среднюю численность пачки медленных электронов для алюминия (табл. 1) и соотношение между h и λ , рассчитывается число вторичных электронов N_{SE} по формуле

$$N_{\rm SE} = \frac{2\lambda}{h} v_c n = 33\,470\,{
m electrons}$$

Таким образом, по грубой оценке число медленных вторичных электронов, возбуждающих плазменные колебания в тонком поверхностном слое карбида кремния толщиной $\lambda \sim 35$ Å, составляет порядка 34 000.

Финансирование работы

Работа выполнена в рамках государственного задания при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ проект № 3.5005.2017/ВУ.

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

Список литературы

- [1] В.М. Стожаров. ЖТФ 87, 1, 125 (2017).
- [2] В.М. Стожаров, В.П. Пронин. ЖТФ 87, 12, 1901 (2017).
- [3] В.М. Стожаров. ЖТФ **89**, 7, 1042 (2019).
- [4] В.М. Стожаров. ЖТФ **90**, 7, 1116 (2020).
- [5] Ч. Киттель. Квантовая теория твердых тел. Наука. М. (1967). 485 с.
- [6] И.М. Бронштейн, И.Л. Краинский. Изв. АН СССР. Сер. физ. 40, 8, 1656 (1976).
- [7] В.Б. Гильденбург, В.А. Костин, И.А. Павличенко. Вестн. Нижегородского ун-та им. И.А. Лобачевского 5, 3, 314 (2011).
- [8] В.В. Климов. Наноплазмоника. Физматлит, М. (2009). 480 с.
- [9] М.А. Румш, В.Н. Щемелев. ФТТ 5, 1, 71 (1963).
- [10] В.Н. Щемелев, Л.Г. Елисеенко, Е.П. Денисов, М.А. Румш. ФТТ 6, 9, 2574 (1964).
- [11] И.М. Бронштейн, Б.С. Фрайман. Вторичная электронная эмиссия. Наука, М. (1969). 400 с.

Редактор Т.Н. Василевская